

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 在硅衬底外延生长GaN材料 (中科院)

请输入查询关键词

科技频道

搜索

在硅衬底外延生长GaN材料 (中科院)

关键词: GaN 外延

所属年份: 2004

成果类型: 应用技术

所处阶段: 中期阶段

成果体现形式: 新材料

知识产权形式:

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 中国科学院上海技术物理研究所

成果摘要:

Si衬底上生长GaN将主要采用低温Alw作缓冲层,用横向生长技术,AlGaIn/GaN超晶格,多次成核的方法来减小GaN层应力和缺陷,发来新的减少应力和缺陷的方法,研究低维结构的生长技术,用X射线衍射,透视电子显微镜,Raman谱,AFM研究其微结构,用变温光荧光、光发射谱、变温Hall,光荧光瞬态谱的方法研究物性。采用制成原型器件的方法研究微结构对器件参数的影响。

成果完成人: 李宁;黄绮

[完整信息](#)

行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库尔勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氢重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

成果交流

推荐成果

- [新型稀土功能材料](#) 04-23
- [低温风洞](#) 04-23
- [大型构件机器缝合复合材料的研制](#) 04-23
- [异型三维编织增减纱理论研究](#) 04-23
- [飞机炭刹车盘粘粘修复技术研究](#) 04-23
- [直升飞机起动用高能量密封免...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场预应力混凝...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场30000立方米...](#) 04-23
- [高性能高分子多层复合材料](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号